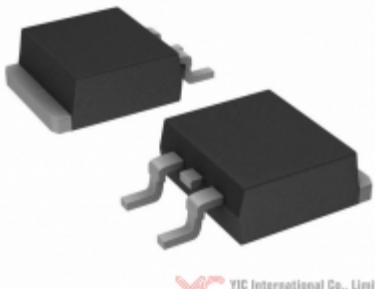









	<h2 style="color: red;">SIHB33N60E-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHB33N60E-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 33A TO-263
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHB33N60E-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 1386 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHB33N60E-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 33A TO-263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1386 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 33A (Tc) 278W (Tc) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 16.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3508pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHB33N60EGE3

SIHB33N60E-GE3 ist neu im Original. Suche SIHB33N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHB33N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHB33N60E-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHB30N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB30N60E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB30N60E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB33N60ET1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO263</p>
 <p><b>SIHB33N60EF-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p><b>SIHB30N60E-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB33N60E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-263</p>	 <p><b>SIHB33N60ET5-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO263</p>

### heiße Teile

Mehr

⚙ SIHA12N60E	↔ SIHA12N60E-E3	⇒ SIHA12N60E-E3	D SIHA22N60E-E3	↔ SIHA22N60E-E3
↳ SIHA25N50E	⚙ SiHB12N50C	D SIHB12N50C-E3	⇒ SIHB12N50C-E3	↔ SIHB12N50E
⚙ SIHB12N60E	↳ SIHB12N60E-GE3	⚙ SIHB12N60E-GE3	↔ SiHB12N65E	↔ SIHB15N50E
D SIHB15N60E-GE3	⚙ SIHB15N60E-GE3	↳ SiHB15N65E	⚙ SiHB16N50C	↔ SIHB16N50CTR-E3
⇒ SIHB18N60E	↔ SIHB33N60E-GE3	⚙ SIHD3N50D-GE3	↳ SIHD3N50D-GE3	↔ SIHD7N60E-GE3
↔ SIHD7N60E-GE3	⇒ SIHF10N40D	D SIHF10N40D-E3	⚙ SIHF10N40D-E3	↳ SIHF12N50C
⚙ SIHF12N50C-E3	D SIHF12N50C-E3	⇒ SIHF12N60E	↔ SIHF12N60E-E3	↔ SIHF12N60E-E3
↳ SIHF12N60E-GE3	⚙ SIHF12N60E-GE3	↔ SIHF12N60E-GE3	⇒ SIHF12N65E	↔ SIHF15N60E
⚙ SIHF15N60E-E3	↳ SIHF15N60E-E3	⚙ SIHF15N60E-EG3	D SIHF15N60E-GE3	↔ SIHF15N60E-GE3
↔ SIHF16N50C	⚙ SIHF16N50C-E3	↳ SIHF16N50C-E3	⚙ SIHF18N50C-E3	↔ SIHF18N50C-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited